

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成27年5月28日 (2015.5.28)

【公開番号】特開2013-177667(P2013-177667A)

【公開日】平成25年9月9日 (2013.9.9)

【年通号数】公開・登録公報2013-049

【出願番号】特願2012-171487(P2012-171487)

【国際特許分類】

C 2 2 C 5/06 (2006.01)

B 2 2 F 1/00 (2006.01)

H 0 1 B 5/14 (2006.01)

H 0 1 B 5/00 (2006.01)

C 2 3 C 14/14 (2006.01)

C 2 3 C 14/34 (2006.01)

H 0 1 B 1/02 (2006.01)

【 F I 】

C 2 2 C 5/06 Z

B 2 2 F 1/00 K

H 0 1 B 5/14 Z

H 0 1 B 5/14 A

H 0 1 B 5/00 F

C 2 3 C 14/14 D

C 2 3 C 14/34 A

H 0 1 B 1/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月10日 (2015.4.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に設けられ、反射膜および / または透過膜、もしくは電気配線および / または電極に用いられる A g 合金膜であって、

前記 A g 合金膜は、A u、および P t よりなる群から選択される少なくとも一種の元素を 0 . 1 ~ 1 . 5 原子%と；L a、G d、および C e よりなる群から選択される少なくとも一種、B i、および Z n よりなる群から選択される少なくとも一種の元素を 0 . 0 2 ~ 1 . 5 原子%と；;を含み、残部は A g および不可避不純物からなることを特徴とする A g 合金膜。

【請求項 2】

更に他の元素として、M g、C u、G e、I nおよび C a よりなる群から選択される少なくとも 1 種の元素を 0 . 1 ~ 2 . 0 原子%含有する請求項 1 に記載の A g 合金膜。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の A g 合金膜の形成に用いられるスパッタリングターゲットであって、

A u、および P t よりなる群から選択される少なくとも一種の元素を 0 . 1 ~ 1 . 5 原子%と；L a、G d、および C e よりなる群から選択される少なくとも一種、B i、およ

びZnよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を0.1～1.5原子%と、;を含み、残部はAgおよび不可避不純物からなることを特徴とするAg合金スパッタリングターゲット。

【請求項4】

更に他の元素として、Mg、Cu、Ge、InおよびCaよりなる群から選択される少なくとも1種の元素を0.1～2.0原子%含有する請求項3に記載のAg合金スパッタリングターゲット。

【請求項5】

請求項1または2に記載のAg合金膜の形成に用いられるAg合金フィラーであって、Au、およびPtよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を0.1～1.5原子%と、La、Gd、およびCeよりなる群から選択される少なくとも一種、Bi、およびZnよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を0.02～1.5原子%と、;を含み、残部はAgおよび不可避不純物からなることを特徴とするAg合金フィラー。

【請求項6】

更に他の元素として、Mg、Cu、Ge、InおよびCaよりなる群から選択される少なくとも1種の元素を0.1～2.0原子%含有する請求項5に記載のAg合金フィラー。

【請求項7】

Ag合金ナノ粒子からなる請求項5または6に記載のAg合金フィラー。

【請求項8】

請求項1または2に記載のAg合金膜を有する電子デバイス。

【請求項9】

請求項1または2に記載のAg合金膜を有する電磁波吸収体。

【請求項10】

請求項1または2に記載のAg合金膜を有する帯電防止フィルム。

【請求項11】

請求項1または2に記載のAg合金膜を有する減光フィルムまたは断熱フィルム。